



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**H8050**

对应国外型号  
SS8050

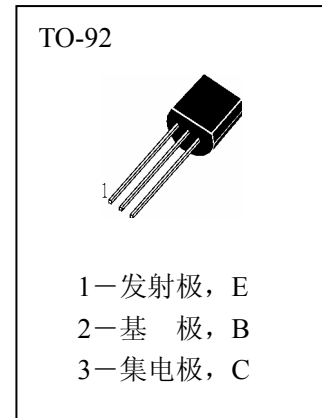
■ 主要用途

作便携式收音机 B 类推挽输出 2W 放大。

■ 外形图及引脚排列

■ 极限值 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

$T_{stg}$	— 贮存温度	.....	-55~150 $^\circ\text{C}$
$T_j$	— 结温	.....	150 $^\circ\text{C}$
$P_C$	— 集电极耗散功率	.....	1W
$V_{CBO}$	— 集电极—基极电压	.....	40V
$V_{CEO}$	— 集电极—发射极电压	.....	25V
$V_{EBO}$	— 发射极—基极电压	.....	6V
$I_C$	— 集电极电流	.....	1.5A



■ 电参数 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			0.1	$\mu\text{A}$	$V_{CB}=35\text{V}, I_E=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			0.1	$\mu\text{A}$	$V_{EB}=6\text{V}, I_C=0$
$H_{FE}$	直流电流增益	85		500		$V_{CE}=1\text{V}, I_C=100\text{mA}$
		40				$V_{CE}=1\text{V}, I_C=800\text{mA}$
$V_{BE(ON)}$	基极—发射极导通电压			1	V	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=10\text{mA}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			0.5	V	$I_C=800\text{mA}, I_B=80\text{mA}$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压			1.2	V	$I_C=800\text{mA}, I_B=80\text{mA}$
$BV_{CBO}$	集电极—基极击穿电压	40			V	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	25			V	$I_C=2\text{mA}, I_B=0$
$BV_{EBO}$	发射极—基极击穿电压	6			V	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$
$f_T$	特征频率	100			MHz	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}$

分档及其标志

B	C	D	E
85—160	120—200	160—300	270—500



■ 特性曲线

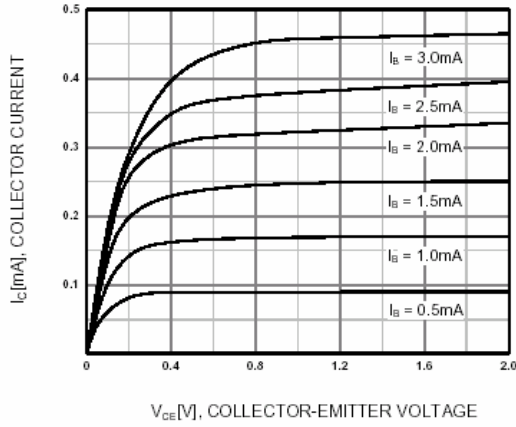


Figure 1. Static Characteristic

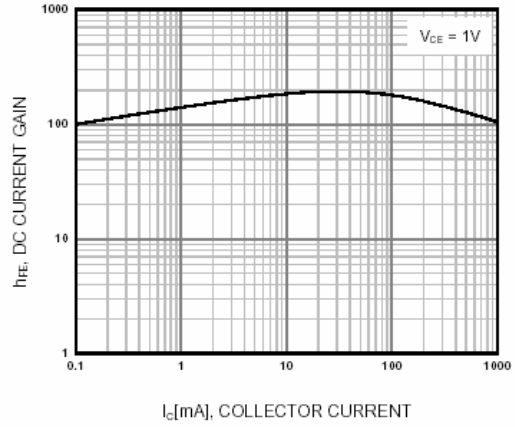


Figure 2. DC current Gain

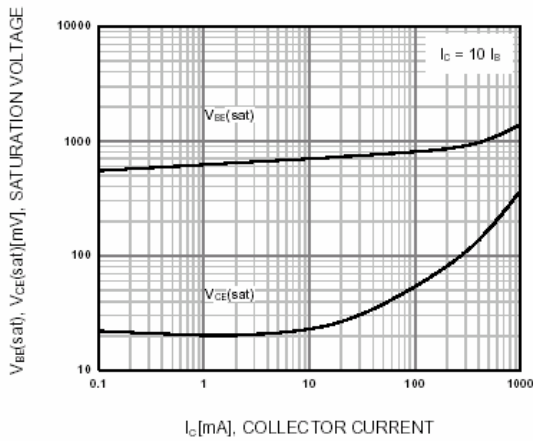


Figure 3. Base-Emitter Saturation Voltage  
Collector-Emitter Saturation Voltage

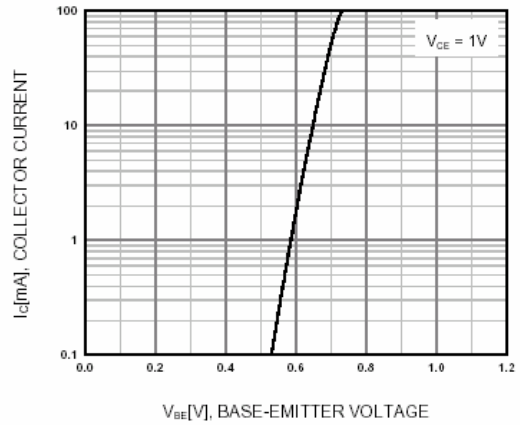


Figure 4. Base-Emitter On Voltage

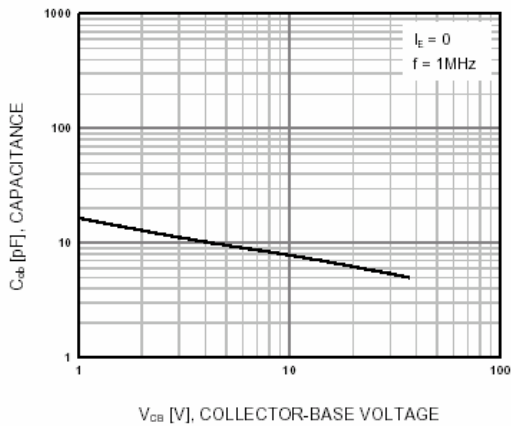


Figure 5. Collector Output Capacitance

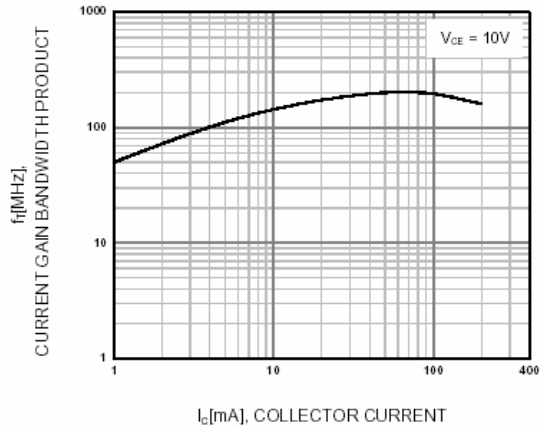


Figure 6. Current Gain Bandwidth Product